

Формат А.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
34584/1	16.12.18			

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
A1		1	БАЖК.758765.003	<u>Детали</u> Плата печатная	1	
		4		<u>Прочие изделия</u> Резонатор РК415-6ВС-7,3728 МГц-16пФ ТУ 6321-002-72715118-06	1	BQ1
			БАЖК.467761.007			Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	2	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
34584/1	10.16.12.10						6		Конденсаторы (EPCOS) B45196H3106K10		6 шт. C2,C6, C15,C20, C22,C31 Взамен поз.13
							7		B45196H3227K50		7 шт. C14,C18, C23,C24, C27,C29, C30 Взамен поз.14
							8		Чип-конденсаторы керамические SMD NPO-0805-50B-33 пФ ±5%	2	C12,C13
							9		NPO-0805-50B-2200 пФ ±5%	3	C32-C34
							10		X7R-0805-50B-0,1 мкФ ±10%	34 8	C11,C19 C21, C35
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм Лист № докум. Подп. Дата БАЗК.467761.007 Лист 3						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
34584/1	Ка-16.12.10						11		Чип-конденсаторы керамические SMD X7R-0805-50B- 1 мкФ ±10%	9 8	C4,C8, C10,C16, C17,C25, C26,C28, C35
							13		Чип-конденсаторы танталовые TAJA106K016/AVX	6	6шт. C2,C6, C15,C20, C22,C31 Доп. замена на поз.6
							14		TAJE227K016/AVX		7шт. C14,C18, C23,C24, C27,C29, C30 Доп. замена на поз.7
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	БАЗК.467761.007						Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							4

					Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Инв. № подл. 3458415	Подп. и дата Ж.О. 16.12.10	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата			15		Конденсаторы ЕСАР (Jamicon, TK series) ЕСАР-50В – 10 мкФ		1 шт., С3 Доп. замена на поз. 21
							16		ЕСАР-50В – 220 мкФ		2 шт., С5,С7 Доп. замена на поз. 22
							17		ЕСАР-50В – 470 мкФ		1 шт., С1 Доп. замена на поз. 23
							19		Конденсаторы (Murata) GRM31CR71A106KA01L		1 шт., С9 Доп. замена на поз. 20
							20		GRM31CR71C106KAC7L		1 шт., С9 Взамен поз.19
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						БАЗК.467761.007	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						Лист	5

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
345846	16.12.10			

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		21		Конденсаторы RD (SAMWHA) RD-50B – 10 мкФ		1 шт., C3 Взамен поз.15
		22		RD-50B – 220 мкФ		2 шт., C5,C7 Взамен поз.16
		23		RD-50B – 470 мкФ		1 шт., C1 Взамен поз.17
Инд. № подл.						Лист
345846						6
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БАЗК.467761.007	

					Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
							27		Микросхемы PRAC37S (SOP-8) KEHC 431156.091TY	2	DA1, DA3
							28		INA138NA (SOT23-5, Texas Instruments)		1 шт. DA2 Взамен поз.30
							30		INA168NA (SOT23-5, Texas Instruments)		1 шт. DA2 Доп. замена на поз. 28
							31		IRF7343 (SO-8, International Rectifier)	1	DA5
							32		LMC7221AIM5 (SOT23-5, National Semiconductor)		3 шт. DA10- DA12 Доп. замена на поз. 33,34,35
							33		LMC7221AIM5X (SOT23-5, National Semiconductor)		3 шт. DA10- DA12 Взамен поз.32
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата							
34584/А	2016.12.10										
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БАЗК.467761.007						Лист
											7

					Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Инв. № подл. 3458417	Подп. и дата 20.10.12.10	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата			34		Микросхемы LMC7221BIM5 (SOT23-5, National Semiconductor)		3 шт. DA10- DA12 Взамен поз.32
							35		LMC7221BIM5X (SOT23-5, National Semiconductor)		3 шт. DA10- DA12 Взамен поз.32
							36		LP2950CDT-3,3 (TO-252, National Semiconductor)	1	DA9
							37		MAX1745AUB (μMAX-10, Maxim)		1 шт., DA7 Взамен поз.38
							38		MAX1745EUB (μMAX-10, Maxim)		1 шт., DA7 Доп. замена на поз. 37
							39		OPA2348AID (SO-8, Texas Instruments)	1	DA6
							40		OPA244UA (SO-8) (Burr-Brown)	1	DA13
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БАЗК.467761.007	
										Лист 8	

					Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
							41		Микросхемы TL431BID (SOIC-8, Texas Instruments)		1 шт., DA8 Доп. замена на поз. 42
							42		TL431BIDR (SOIC-8, Texas Instruments)		1 шт., DA8 Взамен поз.41
							43		TMP01ES (SO-8, Analog Devices)	1	DA4
							44		Микросхемы IW4001BD ТУ РБ 14513714.005-01		1 шт., DD1 Доп. замена на поз. 48
							45		ADM3485EAR (SO-8, Analog Devices)	1	DD4
Инв. № подл.	Инв. № дубл.	Взам. Инв. №	Подп. и дата	Подп. и дата	8-Вам. БАЖК. 29276-11/27.4.11						
34584/17			26.04.11		БАЖК.467761.007						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
											Лист
											9

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
3458417	26.04.11						46		Микросхемы ADuM1301ARW (RW-16, Analog Devices)	1	DD3
							47		ATxmega256A3-AU (64A, Atmel)	1	DD2
							48		MC14001BD ON Semiconductor;751A-03)		1 шт., DD1 Взамен поз.44
							50		Индуктивности B82422-T1334-K EPCOS	1	L2
							51		PE-53809S (LCI, Pulse)	1	L1
							52		DLW31SN222SQ2 (Murata)	1	L3
8-Вам. БАНК 29292-11.02.11	27.4.11								БАЗК.467761.007		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							Лист 10

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
345841	15.09.16.12.10.			

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		53		Резисторы ОЖ0.467.093ТУ C2-33H-0,25-5,1 Ом± 5 % А-Д-В		1шт.,R11 Доп. замена на поз. 55
		54		C2-33H-0,5-1,5 кОм± 5 % А-Д-В	4	R12-R15
		55		Резисторы ШКАБ.434110.006ТУ C2-33M-0,25-5,1 Ом± 5 % А-Д		1шт.,R11 Взамен поз.53
		56		C2-33M-0,5a-120 Ом± 5 % А-Д	1	R44
		57		C2-33M-1-24 Ом± 5 % А-Д	2	R47,R48
		58		C2-33M-1-51 Ом± 5 % А-Д	1	R3
Инв. № подл.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БАЗК.467761.007	
345841						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	
					11	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
34584/1	Бажж 21.01.11						60		ЧИП резисторы 0805-51 Ом $\pm$ 5 %	3	R32,R37 R38
							61		0805-620 Ом $\pm$ 5 %	3	R29,R41, R49
							62		0805-1 кОм $\pm$ 5 %	2	R7,R45
							63		0805-1,5 кОм $\pm$ 5 %	1	R19
							64		0805-2 кОм $\pm$ 1 %	1	R9
							65		0805-2 кОм $\pm$ 5 %	1	R42
							66		0805- 3 кОм $\pm$ 5 %	1	R26
							67		0805-5,1 кОм $\pm$ 5 %	4	R5,R6, R39,R40
							68		0805-6,65 кОм $\pm$ 1 %	1	R20
							69		0805-10 кОм $\pm$ 5 %	3	R16,R28 R43
							70		0805-11 кОм $\pm$ 1 %	1	R21
							71		0805- 47 кОм $\pm$ 5 %	1	R46
							72		0805-100 кОм $\pm$ 5 %	9	R1,R2, R4, R23,R25, R33-R36
							73		0805-110кОм $\pm$ 1 %	1	R10
							74		0805-130кОм $\pm$ 1 %	1	R18, R50 R51
							75		0805-360кОм $\pm$ 1 %	2	R52,R53
							76		0805-360 кОм $\pm$ 5 %	3	R17,R22, R24
7-Зам.	Бажж.1219-1024/21.11								БАЖК.467761.007		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							Лист 12

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
345846	16.12.10			

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		77		Резисторы 3296P-1-502 (Bourns)		1 шт., R27 Доп. замена на поз. 78
		78		PV36P502 (Murata)		1 шт., R27 Взамен поз. 77
		79		P1-8МП-0,25-124кОм ±0,25%-1-Ж ОЖ0.467.164ТУ	1	R8
		82		Варистор SIOV - CN 2220 K 30G (Epcos)	13	RU1- RU13
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Изм Лист № докум. Подп. Дата БАЖК.467761.007 Лист 13	
345846	16.12.10					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
34584/1	16.12.10.			

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		85		Диоды 10BQ040 (SMB, International Rectifier)	2	VD9, VD10
		86		BAT54S (SOT23, NXP)		4 шт., VD5,VD7 VD8, VD11 Взамен поз.87
		87		BAT54S-V (SOT23, VISHAY)		4 шт., VD5,VD7 VD8, VD11 Доп. замена на поз. 86
		88		F3 (DO214AC, FCI Cmpnf)		10шт., VD1-VD4 VD12- VD17 Взамен поз.89
БАЗК.467761.007						Лист 14
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

					Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Инов. № подл. 345847 Подп. и дата Ка 16/12/10 Взам. Инов. № Инов. № дубл. Подп. и дата							89		Диоды		10 шт., VD1-VD4 VD12- VD17 Доп. замена на поз. 88
							92		Стабилитроны		1 шт., VD6 Взамен поз.94
							93		DDZ9690-7 (SOD-123, Diodes inc)		1 шт., VD6 Взамен поз.94
							94		MMSZ4690ET1 (SOD-123, On Semiconductor)		1 шт., VD6 Взамен поз.94
									MMSZ4690-V (SOD-123, Vishay)		1 шт., VD6 Доп. замена на поз. 92, 93
					БАЗК.467761.007						Лист
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	15	

					Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
									Транзисторы		
							96		BC807-40 (SOT-23, Philips)	1	VT6
							97		BC817-40 (SOT-23, Philips)	1	VT7
							98		MMBT5551 (SOT-23, Fairchild Semiconductor)		4 шт., VT1-VT4 Доп. замена на поз. 99
							99		MMBT5551LT1 (SOT-23, Motorola)		4 шт., VT1-VT4 Взамен поз.98
							100		IRLML5203 (Micro3, International Rectifier)	1	VT5
							101		TIP147 (TO-3P, Fairchild Semiconductor)		1 шт., VT8 Взамен поз.102
							102		TIP147 (TO-247, STMicroelectronics)		1 шт., VT8 Доп. замена на поз. 101
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв.№	Инв. № дубл.	Подп. и дата							
34584/5	16.12.10										
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БАЗК.467761.007						Лист
											16

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
34584/1	14.08.11			

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Разъемы Каталог “Бурый медведь” 2009г.		
		105		ВН10	1	XP1
		106		ВН20	1	XP2
		110		<u>Материалы</u> Бумага №1 АК ГОСТ 9095-89	4	см ²
		111		<u>Переменные данные для</u> <u>исполнения</u> <u>БАЖК.467.761.007</u> <u>Прочие изделия</u> 0805-130кОм ± 1 %	2	R50,R51
		111		<u>БАЖК.467.761.007-01</u> 0805-71,5кОм ± 1 %	2	R50,R51
		112		<u>Материалы</u> Провод МГТФ0,12 ТУ16-505.185-71	3	см
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лист	
34584/1	14.08.11				17	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БАЖК.467761.007	

Лист регистрации изменений

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (стр.) в документе	№ док.	Входящий № сопров. документа и дата	Подп.	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					
6	—	все	—	—	18	БАНК. 1178-10	16.12.10		
7	—	12	—	—	18	БАНК. 1219-10	21.1.11		
8	3, 13	9, 10	—	—	18	БАНК. 2922/2-11	27.4.11		
9	1	—	—	—	18	БАНК. 2463/3-11	10.05.11		
10	3, 4	—	—	—	18	БАЖК. 443-11	26.5.11		
11	12	17	—	—	18	БАНК. 5062/2-11	22.6.11		
12	1	—	—	—	18	БАНК. 5862/3-11	04.07.11		
13	—	1, 17	—	—	18	БАНК. 695-11	18.07.11		
14	—	17	—	—	18	БАНК. 810-11	12.08.11		

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
34584/5	15	16.12.10.	16.12.10.	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

БАЖК. 467761.007

Лист
18